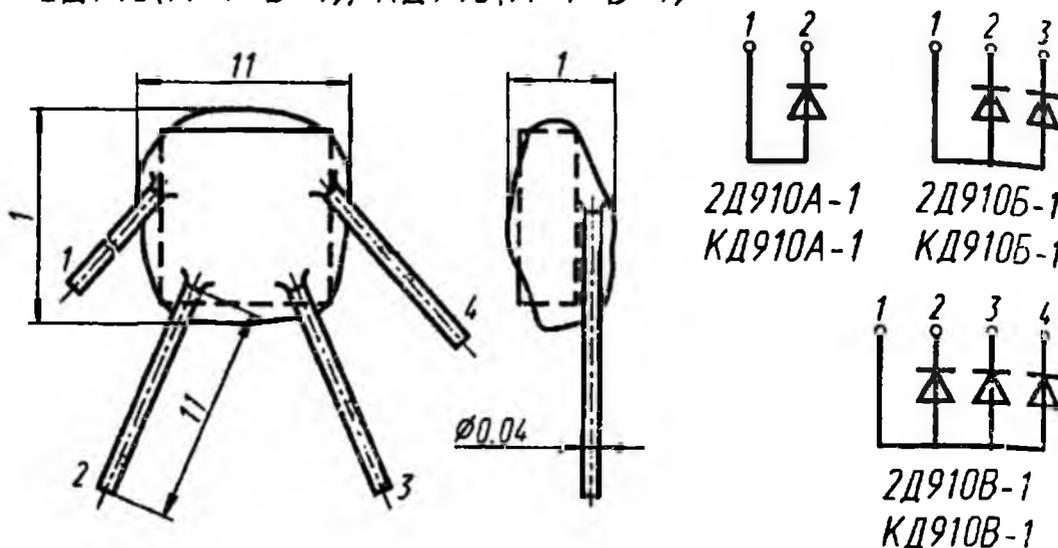


2Д910А-1, 2Д910Б-1, 2Д910В-1, КД910А-1, КД910Б-1, КД910В-1

Диодные матрицы, состоящие из одного (2Д910А-1, КД910А-1), двух (2Д910Б-1, КД910Б-1), трех (2Д910В-1, КД910В-1) кремниевых, планарных диодов, с общим анодом. Предназначены для применения в герметизированной аппаратуре в схемах диодно-транзисторной логики (в формирователях, ограничителях, детекторах сигналов, модуляторах и демодуляторах, шифраторах и дешифраторах). Бескорпусные, с гибкими выводами, без кристаллодержателя. Тип матриц приводится на упаковочном листе групповой тары. Матрицы маркируются на индивидуальной таре цветным кодом: 2Д910А-1, КД910А-1 — одной красной точкой; 2Д910Б-1, КД910Б-1 — двумя красными точками; 2Д910В-1, КД910В-1 — тремя красными точками.

Масса матрицы не более 0,01 г.

2Д910(А-1-В-1), КД910(А-1-В-1)



Электрические параметры

Постоянное прямое напряжение:

при $I_{пр} = 0,05$ мА, не менее:

T = +25 °С	0,5 В
типовое значение	0,57* В
T = +85 °С	0,34 В

при $I_{пр} = 1$ мА, не более:

T = +25 °С	0,8 В
типовое значение	0,77* В
T = -60 °С	1,1 В

Постоянный обратный ток диода

при $U_{OBR} = 5 \text{ В}$, не более:

$T = +25 \text{ }^\circ\text{C}$	0,5 мкА
типовое значение	0,02* мкА
$T = +85 \text{ }^\circ\text{C}$	10 мкА

Время обратного восстановления при

$I_{пр, и} = 5 \text{ мА}$, $U_{OBR, и} = 5 \text{ В}$, $I_{OBR} = 2 \text{ мА}$, $Q \geq 100$, не более	5 нс
---	------

Общая емкость при $U_{OBR} = 0,1 \text{ В}$,

$f = 1...10 \text{ МГц}$, не более	1,5 пФ
---	--------

Предельные эксплуатационные данные

Импульсное обратное напряжение	5 В
Импульсный прямой ток (суммарный ток всех диодов матрицы):	
при $T = -60...+55 \text{ }^\circ\text{C}$	10 мА
при $T = +85 \text{ }^\circ\text{C}^1$	5 мА
Температура окружающей среды	$-60...+85 \text{ }^\circ\text{C}$

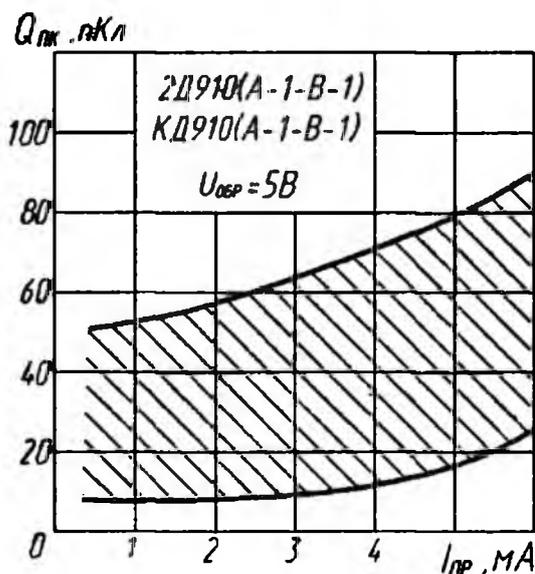
¹ В диапазоне температур $+50...+85 \text{ }^\circ\text{C}$ ток снижается линейно.

Изгиб выводов допускается не ближе 0,3 мм от защитного покрытия.

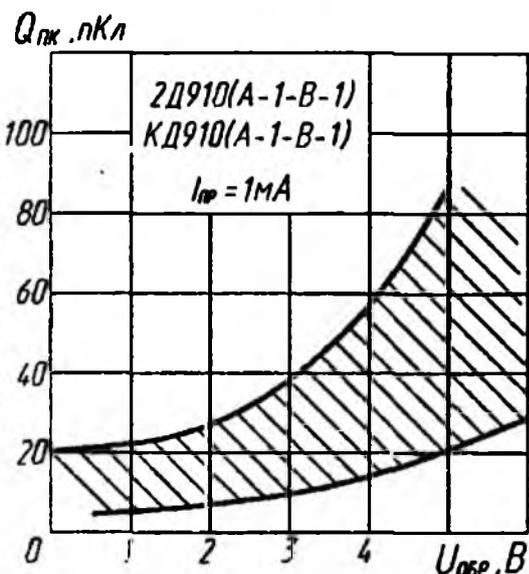
Пайка (сварка) выводов допускается не ближе 2 и не далее 7 мм от защитного покрытия. Нагрев кристалла и защитного покрытия не должен превышать $+85 \text{ }^\circ\text{C}$.

При включении матрицы в измерительную или испытательную схему, находящуюся под напряжением, общий вывод (анод) должен присоединяться первым и отключаться последним.

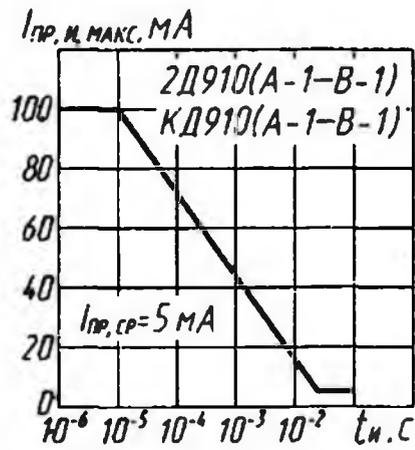
Защитное покрытие изготовлено из эмали ЭП-91.



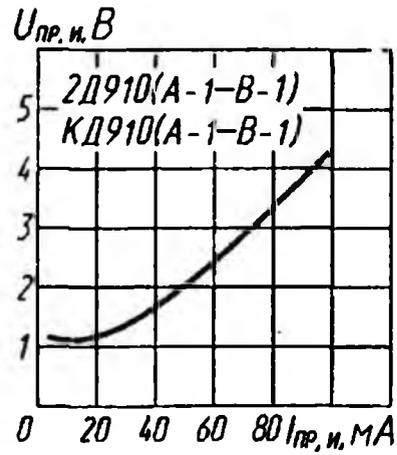
Зона возможных положений зависимости заряда переключения от тока



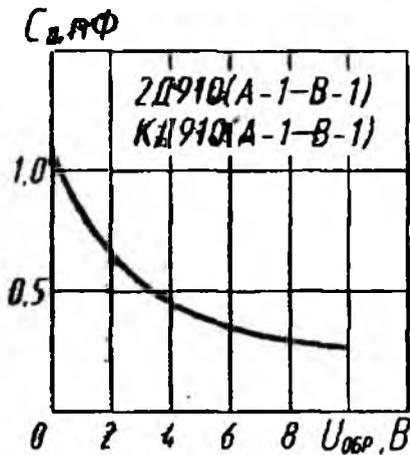
Зона возможных положений зависимости заряда переключения от напряжения



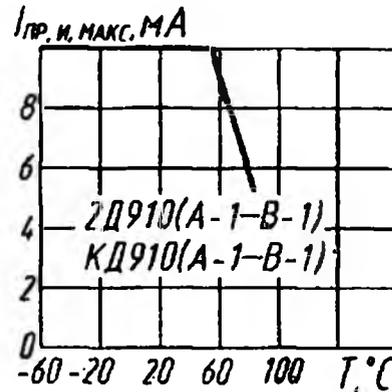
Зависимость допустимого импульсного прямого тока от длительности импульса



Зависимость импульсного прямого напряжения от импульсного прямого тока



Зависимость общей емкости диода от напряжения



Зависимость допустимого импульсного прямого тока от температуры